

Silicon Diode

BA174

25V / 115mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1972/73

BA 174

Nicht für Neuentwicklungen

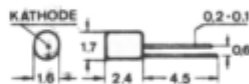
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode für Schaltanwendungen in Siebdruckschaltungen.

Silicon epitaxial planar diode for switching applications in hybrid circuits.

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm

M 2:1



Kunststoffgehäuse
DOM 22
Gewicht · Weight
max. 0,01 g

Absolute Grenzdaten · Absolute maximum ratings

Sperrspannung	U_R	25	V
Spitzensperrspannung	U_{RM}	35	V
Richtstrom	I_O	75	mA
Durchlaßstrom	I_F	115	mA
Spitzendurchlaßstrom	I_{FM}	225	mA
Stoßdurchlaßstrom $t_p \leq 1 \mu s$	i_{FM}	2	A
Verlustleistung $t_{amb} \leq 25^\circ C$	$P_V^{1)}$	62	mW
Sperrschichttemperatur	t_j	125	$^\circ C$
Lagerungstemperatur	t_{stg}	-55...+125	$^\circ C$

¹⁾ In einem vergossenen Modul wird die zulässige Verlustleistung größer und muß von Fall zu Fall bestimmt werden.
In a sealed-in modul the power dissipation is higher and must be checked.

BA 174

		Min.	Typ.	Max.
Wärmewiderstand · Thermal resistance				
Sperrschicht-Umgebung	R_{thJA}			1,6 °C/mW
Kenngößen · Characteristics				
Umgebungstemperatur $t_{amb} = 25^{\circ}C$, falls nicht anders angegeben				
Durchlaßspannung				
$I_F = 30\text{ mA}$	$U_F^{1)}$		1	V
Sperrstrom				
$U_R = 25\text{ V}$	I_R		100	nA
$U_R = 25\text{ V}, t_{amb} = 100^{\circ}C$	I_R		50	μA
Durchbruchspannung				
$I_R = 5\ \mu A$	$U_{(BR)}$	35		V
Diodenkapazität				
$U_R = 0\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$	C_D		16	pF
Rückwärtserholzeit				
$I_F = 10\text{ mA}, U_R = 6\text{ V}$	t_{rr}		35	ns
$i_R = 1\text{ mA}, R_L = 100\ \Omega$				

1) $t_p = 0,01, t_p = 0,3\text{ ms}$